## المجلة الأردنية للفيزياء

### ARTICLE

## معدل القشط العام لكاشف الأثر CR-39 المعرّض لأشعة غاما باستخدام طريقة D-Le

**ياسر يحيى قاسم** قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق.

Received on: 9/2/2014;	Accepted on: 4/10/2015	

الملخص: تم إيجاد معدل القشط العام للكاشف CR-39 تحت تأثير أشعة غاما من <sup>60</sup>Co وذلك باستخدام طريقة قياس قطر- طول الأثر (D-L<sub>e</sub>). شُعْع الكاشف بجسيمات ألفا من مصدر الامريشيوم 2.5 MeV وذلك باستخدام طريقة قياس قطر- طول الأثر (D-L<sub>e</sub>). شُعْع الكاشف بجسيمات ألفا من مصدر الامريشيوم 2.5 MeV معاماً عند معدل جرعة 0.306 التعريض لأشعة غاماً عند معدل القشط العام بوصفها دالة لجرعة الامتصاص لأشعة غاماً عند معدل جرعة 0.306 بالتعريض لأشعة غاماً من معدل القشط العام بوصفها دالة لجرعة الامتصاص لأشعة غاماً عند معدل جرعة 0.306 بالتعريض لأشعة غاماً من معدل القشط العام بوصفها دالة لجرعة الامتصاص لأشعة غاماً عند معدل جرعة 0.306 بالتعريض لأشعة غاماً من معدل القشط العام (V<sub>B</sub>) يزداد تقريباً KGy/h ولجرعات مختلفة تراوحت بين My/i (28.2 - 0.0). لقد وجد أن معدل القشط العام (D<sub>B</sub>) يزداد تقريباً بشكل أسي مع الجرعة (D<sub>B</sub>)، وان قيمته كانت بينm/hr (3.838-1703) بالترتيب تبعاً للجرعات المُختبَرة، وان قيمة معلم الخاصية للتعرض لأشعة كاماً وان قيمته كانت بين My/i (D-28.2 - 0.0). لقد أظهرت طريقة القياس معدل القشط العام (D<sub>B</sub>) يزداد تقريباً معدل أسي مع الجرعة الحرعات المُختبَرة، وان قيمة معدل أن معدل القشط العام (C<sub>B</sub>)، وان قيمته كانت بينMh (B-3.808) بالتروني طريقة القياس معدل القشط العام (D<sub>1</sub> معدل القشط العام للكاشف (C<sub>1</sub> - 0.2 المعرض لأشعة كاماً روان قيمته كانت أخرين استخدموا طرائق قياس مختلفة.

# Bulk Etch Rate of CR-39 Track Detector Exposed to Gamma Dose using D-L<sub>e</sub> Method

Y. Y. Kasim Physics Department, College of Education for Pure Science, Mosul University, Iraq.

#### **Extended Abstract:**

The use of solid state track detectors (SSNTD's) has already become well-known which has been extensively used in nuclear physics, space physics, biophysics, geology, nuclear engineering, monitoring radon concentrations of radon gas by recording their emitted alpha particles and in many other field. It is known that some plastic types of the solid state nuclear detector such as polycarbonate CR-39 and PM-355, cellulose nitrate CN-85 and LR-355 or cellulose acetate CA-80 are highly sensitive to ionizing radiations and charged particles.

Operation of the solid-state nuclear track detector is based on the fact that a heavy charged particle which is heavier than electron will cause extensive ionization of the material when it passes through a medium. Along the path of the alpha particle, a zone enriched with free chemical radicals and other chemical species is then created. This damage zone is called a latent track. Now when a piece of material containing latent tracks is exposed to some chemically aggressive solution, chemical reaction would be more intensive along the latent track. The overall effect is that the chemical solution etches the surface of the detector material, but with a fast rate in the damaged region. In this way a track of the particle is formed, which may be seen under an optical microscope or by other counting techniques.

The secondary electrons or  $\gamma$ -rays should also contribute to produce damage in plastic detectors. Though low LET radiation such as  $\gamma$ - rays or electrons cannot form any etchable tracks, in the plastic detectors, it is observed that some changes in macroscopic properties of the detector such as the sensitivity, the etching rates, the brittleness or change in color all are induced when irradiation dose becomes higher than about Mrad. An increase of bulk etching rate has been reported as the most striking change among macroscopic properties. Recently researchers keep on investigating irradiation effects of low LET radiation such as  $\gamma$ -rays, UV-light or electrons by using and developing various methods and different approaches for measuring parameters of solid state nuclear track detectors, such as the track etch rate (V<sub>T</sub>), the bulk etch rate (V<sub>B</sub>), the sensitivity (V), the etched track length (L<sub>e</sub>) and how these parameters are varied with the detector depth in analog with the variations in the track growing stages. Accordingly, this study deals with investigating irradiation effects of low LET radiation of  $\gamma$ -rays on the bulk etch rate of (V<sub>B</sub>) of the plastic polycarbonate solid state nuclear track detector CR-39 using tracks diameter-length (D-L<sub>e</sub>) measurement approach.

A group of five pieces of plastic detector CR–39 of thickness 250  $\mu$ m and dimension (1.5x1.5) cm<sup>2</sup> were used. Four of them were exposed to  $\gamma$ -rays from <sup>60</sup>CO (368.21Ci) of does rate 0.306 kGy/h with doses (2.754, 4.590, 6.426, 8.262) kGy regarded to irradiation times (9, 15, 21, 27) h respectively, while the last detector piece was left without  $\gamma$ -rays irradiation. Both  $\gamma$ -rays irradiated and un-irradiated detectors were then directly irradiated by alpha particles of energy 3.5 MeV from <sup>214</sup>Am(1 $\mu$ Ci) source.

In order to reveal alpha particles tracks, the detectors were etched by the aqueous solution of KOH of molarity 6.5 N at a temperature (70±1) °C for (1.5-4) h with recurrent increase 0.5 h. The profiles of the tracks and their diameters and lengths were measured using the digital camera MDCE-5A fixed on an optical microscope and connected to a computer. Using the track diameter-length (D-L<sub>e</sub>) measurement approach the bulk etch rate (V<sub>B</sub>) was measured as a function of  $\gamma$ -rays absorbed dose. It was found that the bulk etch rate (V<sub>B</sub>) increased exponentially with the dose (D $\gamma$ ), and its value was between (1.703-3.838) µm/hr corresponding to the examined  $\gamma$ -rays doses. The  $\gamma$ -irradiation characteristic parameter (g) was also calculated and it was found equals to 94.5 MGy<sup>-1</sup>. However, the D-L<sub>e</sub> measurement method of the bulk etch rate of the detector CR-39 exposed to  $\gamma$ -doses showed a good agreement with others used different measurement methods and approaches. **Keywords:** Track detector; CR-39; Gamma-ray exposure; Dose-rate; Bulk etch rate.

المقدمة

حساسيته مثل نقاوة المونمر، والتركيب الجزيئي للبوليمر، وظروف البلمرة [3].

إن دراسة تأثير العوامل البيئية في الكاشف تمكننا من معرفة وقياس التأثيرات الحقيقية للجسيمات المشحونة التي بقصف بها الكاشف. ومهما يكن تأثير العوامل البيئية في الكاشف إيجابية كانت أم سلبية فإنها مفيدة في جوانب متعددة؛ فمثلاً التأثيرات السلبية للأشعة الكهرومغناطيسية عند ظروف معينة تعمل على صلابة الكاشف البوليمري (البلاستيكي) ونقصان حساسيته للجسيمات المشحونة وهي تعد سلبية في الكشف عن الجسيمات بينما تعد ايجابية في الاستعمالات الصناعية للكاشف البوليمري.

إن التأثير الكبير والملحوظ لدرجة الحرارة المتمثلة بالتلدين والتبريد على الصفات الكشفية والقشطية وسهولة إنجاز هذه العملية أدت إلى دراسات مختلفة لمعرفة هذا التأثير قبل قصف الكاشف بالجسيمات وبعده، في حين أن تأثير الأشعة الكهرومغناطيسية لا يأخذ المدى نفسه لكون هذه العملية تحتاج إلى طاقات وجرعات عالية للوصول إلى تأثيرات ملحوظة، فضلاً عن أن تلك التأثيرات تكون غير منتظمة وقد تتغير آنياً بتغير معلمات الإشعاع ومعلمات المادة المعرضة لها. فالأشعة الكهرومغناطيسية ذات الطاقات يعد معدل القشط العام معلماً كشفياً من معالم الكاشف إذ يعتمد على عوامل عدة, منها نقاوة المادة الأساسية المصنع منها الكاشف، ومدى تجانسها وتماثل خواصها، وطبيعة جزيئات الكاشف البوليمري، وظروف بلمرتها خلال عملية إنتاج الكاشف فضلاً عن اعتمادها على العوامل البيئية أثناء تشعيع الكاشف. إلى جانب كون V<sub>B</sub> معلماً كشفياً فانه يعد معلما قشطياً (Etching Parameter) مهما أيضاً، إذ أنه يعتمد على نوع المحلول الكيميائي القاشط وتركيزه ودرجة حرارته [1:4].

تلعب العوامل البيئية دوراً كبيراً في التأثير على الصفات الكشفية والتسجيلية لكواشف الأثر النووي البلاستيكية (SSNTD's) كالحساسية، والزاوية الحرجة، ومعدلات القشط العام والأثر. ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى نوعين: الأول هي العوامل الفيزيائية ومن أمثلتها الأمواج فوق الصوتية، والمجال الكهربائي، ودرجات الحرارة العالية، والجرعات العالية من الإشعاعات الكهرومغناطيسية. والنوع الثاني هي العوامل الكيميائية مثل نوع المحلول القاشط، وتركيزه، ودرجة حرارته، ونوع المحاليل المضافة إلى المحلول القاشط فضلاً عن وجود الأوكسجين والرطوبة والماء، وظروف الخزن [3،4،6]. وهناك عوامل أخرى تخص الكاشف نفسه، ولاسيما العضوية منها، لها تأثير على

العالية تفقد جزءا معينا من طاقاتها عند مرورها في كل وحدة سمك معين من المادة المخترقة، وإن طاقتها تتضاءل تدريجياً بزيادة عمق الاختراق، كما إن امتصاصها من قبل المادة يعتمد على طاقة فوتوناتها والجرعة (أي زمن التعرض لها)، وعلى كثافة المادة المعرضة لها والعدد الذري لمكوناتها [6]. إن تعرض الكواشف النووية الصلبة إلى جرع من الأشعة الكهرومغناطيسية والالكترونات لا تفضي إلى إنتاج آثار (مسارات) ملحوظة في تلك الكواشف مثل ما تتركه الجسيمات المشحونة والتي كتلتها أكبر من كتلة الالكترونات الناتجة عن تفاعل الفوتونات مع مادة الكاشف، ولكنها قد تترك تأثيرات واضحة المعالم في صفات وخصائص تلك الكواشف [7].

إن التأثير الناتج عن تفاعل الإشعاع مع الكواشف البوليميرية يختلف كما عن التأثير الناتج عن درجة الحرارة. ولهذا فعند تعرض الكاشف CR-39 والذي يمتاز بحساسية وكفاءة عاليتين فى الكشف عن الجسيمات إلى إشعاع كهرومغناطيسى يؤدي ذلك إلى كسر السلسلة الرئيسة لمجموعة الكاربونيل مما يؤدي إلى انحلال البوليمر وتكون الجذور الحرة، ووجود الأوكسجين له دور كبير، إذ يعد عاملاً مؤكسداً يُسرِّع من عملية الانحلال ويقلل من الاستقرارية الحرارية للبوليمر (thermal stability) فيمنع إعادة ارتباط الجذور الحرة أو السلاسل المكسرة الناتجة مما يقلل من الوزن الجزيئي للمادة. إن المناطق التي تمتاز بوزن جزيئى قليل تمتلك طاقة كامنة أكبر من المناطق السليمة وهذا يسهِّل عملية انحلال الكاشف ويُسرِّعها عند إجراء عملية القشط عليه بعد قصفها بالجسيمات المشحونة، وبذلك تزداد معدلات القشط V<sub>B</sub> وV. وقد يؤدى دخول الجذور في تفاعلات معينة إلى حصول تشابك فى السلاسل البوليمرية (cross linking) مما يزيد من الوزن الجزيئى للبوليمر وهذا يؤدي إلى نقصان معدل القشط VB، لذا فان وجود الأوكسجين يعد مهما لمنع إعادة ارتباط الجذور الحرة.

لقد وجد أن الكاشف 39-CR الذي يقصف بالجسيمات المشحونة مثل جسيمات ألفا إذا ما تعرّض لأشعة غاما قبل قصفها بالجسيمات المشحونة أو بعدها فإن ذلك يؤدي إلى زيادة حساسية الكاشف وكذلك زيادة أقطار الآثار وأطوالها [5, 8]، فضلاً عن أنه يظهر تأثيراً واضحًا في معدلات القشط مثل معدل القشط العام VB والأثر VT ونسبة معدل القشط (الاستجابة) V للكاشف، إذ أن معدلات القشط تعتمد نوع الإشعاع الكهرومغناطيسي وشدته وطاقته [2].

وتعد طريقة قياس طول- قطر الأثر (L<sub>c</sub>-D) في حساب معدل القشط العام V<sub>B</sub> للكاشف واحدة من الطرائق التي تتطلب الحصول على صور للآثار المتكونة في الكاشف، وتتطلب قياساً دقيقاً لكل من قطر الأثر (D) وطوله (L<sub>c</sub>) تجريبياً [10, 9] إذ يتم حساب معدل القشط العام (V<sub>B</sub>) من العلاقة [11]:

$$V_{\rm B} = \frac{D^2}{4tL_{\rm e}} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{4L_{\rm e}^2}{D^2}} \right]$$
(1)

حيث L<sub>e</sub> هو طول الأثر، D قطر فتحة الأثر وt زمن القشط.

يهدف البحث إلى إيجاد معدل القشط العام (V<sub>B</sub>) يهدف البحث إلى إيجاد معدل القشط العام (CR-39 بطريقة قياس قطر-طول الأثر لكاشف الأثر النووي 20-93 المعرض لجرعات من أشعة غاما، وإمكانية الوصول إلى عمل معايرة للكاشف CR-39 باستخدام التشعيع لقياس جرعات غاما.

#### طريقة العمل

استعملت خمس قطع من الكاشف CR-39، بسمك 250μm وبأبعاد cm² (1.5×1.5) وصُقِلت حافاتها لجعلها ناعمة وخالية من الخدوش قدر الإمكان للحصول على حافات حادة لإجراء قياسات دقيقة. تم تعريض أربع قطع من الكاشف تحت نفس الظروف إلى ثلاث جرعات معينة من أشعة غاما وهي kGy (8.262, 6.426, 4.590, 2.754) أ لأربع فترات زمنية h(27, 21, 15, 9)h من مصدر الكوبلت Co<sup>™</sup> نوع (Model C 198) معدل جرعته عند إجراء التجربة هو 0.306 kGy/h، فيما تركت القطعة الخامسة كنموذج قياسى بدون تعريض لأشعة غاما. شُعِّعت القطع المُعرِّضة لأشعة غاما وكذلك النموذج القياسي بجسيمات ألفا بطاقة MeV من مصدر الأمريشيوم (1µCi) <sup>241</sup>Am الباعث لجسيمات ألفا معدل طاقتها القصوى 4.16 ومتوسط مداها في الهواء يقرب من 4.16 cm، وقد تم الحصول على الطاقة 3.5 MeV من خلال تغيير البعد بين المصدر المشع والكاشف في الهواء.

أستعملت المادة الكيميائية القلوية KOH نقاوتها 95% بدرجة حرارة C° (1±70) وعيارية 6.25 في عملية القشط الكيميائي لقطع الكواشف لإظهار آثار جسيمات ألفا المتكونة فيها. تم تصوير الأشكال الجانبية (profiles) للآثار المقشوطة لجسيمات ألفا في الكواشف المُعرِضة لجرعات غاما وكذلك في النموذج القياسي غير

المعرض لأشعة غاما وقيست أقطارها وأطوالها لجميع أزمان القشط المتعاقبة لنمو الأثر ضمن مرحلة الشكل المخروطي المنتظم ومرحلة القشط المفرط (over-etched). وباستعمال طريقة قياس قطر- طول الأثر (D-Le). [10:11.9] من الصور المباشرة للأثار فقد تم حساب قيم معدل القشط العام V<sub>B</sub> للكاشف CR-39 المعرض لأشعة غاما وقورنت مع تلك التي تم قياسه للنموذج القياسي غير المعرض لأشعة غاما. استعملت في الحصول على صور الأثار كاميرا رقمية MDCE-5A مثبتة ما المجهر الضوئي وموصلة إلى حاسوب يعمل ضمن برنامج معين (software) مرفق مع الكاميرا يتم تنصيبها في الحاسبة لغرض إجراء قياسات أقطار الأثار وأطوالها.

#### النتائج والمناقشة

يبين الشكل (1) العلاقة بين أقطار الآثار مع زمن القشط لجسيمات ألفا في كاشف CR-39 المُعرَض لجرعات مختلفة من أشعة غاما، إذ يُلاحظ أن العلاقة ليست خطية تماما بل شبه أسية إذ يزداد قطر الأثر مع زيادة زمن القشط ضمن مرحلة النمو المخروطي المنتظم لشكل الأثر ويستمر بالزيادة مع تقدم القشط في مرحلة القشط المفرط خارج مدى الجسيم في الكاشف.

أما الشكل (2) فانه يبين العلاقة بين طول الآثار وزمن القشط لجسيمات ألفا في كاشف CR-39 المُعرّض لجرعات مختلفة من أشعة غاما، إذ يلاحظ من الشكل أن طول الأثر ينمو بشكل أسى تقريبا وبصورة تدريجية مع تقدم عملية القشط وصولا إلى أقصى قيمة له والتى تمثل نقطة التشبع (saturation) أو الثبوت والتي تمثل نهاية المرحلة الأولى لنمو الأثر وهى مرحلة المخروط المنتظم وبداية المرحلة الثانية للنمو وهى مرحلة القشط المفرط. وهذا يحدث مع وصول المحلول القاشط إلى نهاية المسار المتضرر وهى نهاية مدى الجسيم في الكاشف والذي يمثل وصول رأس الأثر المقشوط إلى هذه النقطة إذ يكون الأثر الناتج مخروطى الشكل ذا نهاية مستدقة أو مدببة (cone tip). إن القيمة القصوى لطول الأثر أو قيمة التشبع والثبوت تعتمد على طاقة الجسيم الساقط وكذلك تعتمد  $(\mathrm{L}_{\mathrm{max}})$ على نوع الكاشف وتركيبه ومنشأه، وإنها ترتبط بشكل وثيق بمعدل نمو الأثر. ويلاحظ من الشكلين (1 و2) أيضا أن تأثير أشعة غاما يكون منتظماً حيث أن زيادة جرعة غاما تؤدي إلى زيادة أقطار وأطوال الآثار وتسارع معدل نمو الأثر ووصول طول الأثر إلى حالة التشبع بشكل أسرع.



الشكل (1): أقطار الآثار مع زمن القشط لجسيمات الفا في كاشف 39-CR المُعرِّض لأشعة غاما.



الشكل (2): أطوال الآثار مع زمن القشط لجسيمات ألفا في كاشف CR-39 المعرض لأشعة غاما

ويعزى سبب الزيادة في أقطار الآثار وأطوالها في أعلاه إلى أن تعرض الكاشف إلى أشعة غاما يؤدي إلى تحفيز جزيئات البوليمر للكاشف وتأيينها، وهذا يعنى حصول تحلل فى مادة الكاشف. وتعد عملية التحلل هذه ذات أهمية كبيرة لأن البوليمر يعتمد إلى حد كبير على طول السلسلة البوليمرية وترتيبها إذ أنَ هذا التحلل يؤدي إلى زيادة الطاقة الكامنة للكاشف المعرّض لأشعة غاما ويؤدى إلى خفض الحاجز الطاقوى للتفاعل بين جزيئات المحلول القاشط وجزيئات الكاشف. وبتشعيع هذه الكواشف المُعرّضة لأشعة غاما بجسيمات ألفا تضاف طاقة إضافية أخرى كبيرة للمناطق الساقطة عليها الجسيمات والتى تعمل على كسر أواصر إضافية وتكوين جذور حرة أكثر على طول على طول مسارها في الكاشف، وبذلك تعمل على زيادة إضافية للطاقة الكامنة للمناطق الساقطة عليها الجسيمات. إن هذه الزيادة فى الطاقة الكامنة لتلك المناطق المشععة بجسيمات ألفا تؤدى إلى زيادة عدد الجزيئات الداخلة في التفاعل مع المحلول القاشط وزيادة معدل التفاعل ومن ثم انحلال أكثر لمادة الكاشف مما يعنى زيادة معدلى القشط العام V<sub>B</sub> والأثر V<sub>T</sub> للكاشف. إن زيادة جرعة أشعة غاما تعنى إعطاء طاقة إضافية أكثر للكاشف ومن ثم زيادة أكثر لعدد الأواصر المكسرة عند تشعيعها بالجسيمات المشحونة والتى تعمل على إنتاج ضرر أكبر في الكاشف وهذا يعنى دخول جزيئات أكثر في منطقة الضرر في عملية التفاعل مع المحلول

القاشط وبالتالي زيادة في كمية المادة المنحلة من الكاشف وزيادة أكثر لمعدلات القشط.

يُبِيِّن الشكلان (3) و(4) على التوالي العلاقة بين مربع قطر الأثر مع حاصل ضرب فترة القشط فى طول الأثر  $(D^2)$  المتكون خلال هذه الفترة  $(L_e t_o D^2)$ ، ومربع طوله  ${}^{2}_{
m e}$ .3.5 MeV و ${}^{2}_{
m e}$  لتلك الفترة الزمنية لطاقة جسيمات ألفا لجرعات أشعة غاما التي عُرِّض لها الكاشف (8.262) 6.427, 4.590, 2.754, 0.0) kGy كافة. يلاحظ من  $(L_e^2 extbf{0}^2)$  الشكلين أن العلاقة بين كل من  $(D^2 extbf{0} extbf{0}^2)$  و $(L_e^2 extbf{0}^2)$ هى علاقة خطية فى مرحلة الشكل المخروطى المنتظم للأثر، وأن هذه العلاقة لا تستمر بالتغير بشكل خطى مع زيادة ساعات القشط لأكثر من هذه المرحلة، لأن طول الأثر يزداد مع زيادة زمن القشط ويصل إلى التشبع والثبوت في نهاية المرحلة الأولى عندما يصل رأس الأثر المقشوط إلى نهاية مدى الجسيم في الكاشف، ويستمر بالثبوت في مرحلة القشط المفرط فى حين يستمر قطر الأثر بالزيادة مع تقدم القشط فى مرحلة القشط المفرط خارج مدى الجسيم فى الكاشف. وعليه فإن القياسات في هذا البحث يجب أن تكون ضمن مرحلة المخروط المنتظم لشكل الأثر لجرعات أشعة غاما التي عُرِّض لها الكاشف وكما هو واضح من الشكلين (2 و3).



الشكل (4): العلاقة بين <sup>2</sup>. وD<sup>2</sup> و

إن اقتصار القياسات على المرحلة الأولى لنمو الأثر، والتي تنتهي مع وصول رأس الأثر المقشوط إلى نهاية مدى الجسيم في الكاشف حيث يصبح الأثر تام القشط (-over etched)، يعود سببه إلى تشبع طول الأثر وثبوته في المرحلة الثانية (مرحلة القشط المفرط) على الرغم من استمرار أقطار الآثار بالزيادة مع تقدم القشط. فالقشط في المرحلة الثانية يحصل في المنطقة السليمة تحت (خارج) منطقة التلف الناتج من الجسبمات الساقطة على الكاشف

ويبدأ رأس الأثر المقشوط بالولوج الى هذه المنطقة حيث يكون على بعد اكبر من مدى الجسيم في الكاشف. ونتيجةً لذلك فإن عمق الاثر (x)، والذي يمثل المسافة من سطح الكاشف الأصلي إلى نهاية الأثر المقشوط، يكون اكبر من مدى الجسيم في الكاشف(R)؛ أي أن R<x. وعليه فإن المدى المتبقي ('R)، والذي يمثل المسافة المتبقية بين رأس الأثر المقشوط ونهاية مدى الجسيم على طول المسار المتضرر، تصبح قيمته سالبة حسب المعادلة R=R وان

الأثر الناتج لا يكون مخروطي الشكل مدبب الرأس بل مدور(rounded) الرأس. فالأثر المقشوط الناتج هذا لا يمثل الأثر الحقيقي لأنه خارج منطقة التلف على بعد اكبر مدى الجسيم وحينها لا يُسمَّى أثرا بل يُسمَّى حفرة القشط (etch pit)، ولهذا يجب التوقف عن قياسات معلمات الأثر مع الدخول إلى المرحلة الثانية من القشط [12].

من نتائج الشكلين (3 و4) واستعمال العلاقة (1) فقد تم حساب معدلات القشط العام (V<sub>B</sub>) للكاشف CR-39 المُعرِّض لجرعات مختلفة من أشعة غاما وكما موضح في الجدول (1). ولعمل معايرة للكاشف CR-39 لجرعات غاما فقد تم رسم معدل القشط العام للكاشف بوصفها دالة لجرعة (جرعة الامتصاص) لأشعة غاما كما موضح في الشكل (5)، ووجد انه يزداد تقريبا بشكل أسي (exponentially) مع زيادة جرعة غاما حسب العلاقة:

$$y = 1.727 e^{0.0945x}$$
(2)

ما تم عمله هو مواءمة (fitting) المُعطيات مع الدالة الأسدَة:

$$y = a e^{bx}$$
(3)

الجدول (1): معدل القشط العام بطريقة Le-D للكاشف المعرض لأشعة غاما

$D_{\gamma}$ (kGy)	$V_{\rm B}$ (µm/h)	$Ln(V_B\gamma/V_{Bo})$
8.262	3.838	0.813
6.427	3.073	0.590
4.590	2.630	0.435
2.754	2.331	0.314
0.00	1.703	0.00



الشكل (5): تغير معدل القشط العام للكاشف CR-39 مع جرعة أشعة غاما

إن المعادلة (3) تتفق مع ما وجده [14،13] في دراستهم لمعدل القشط العام V<sub>B</sub> للكواشف المُعرِّضة لأشعة غاما بطرائق قياس أخرى وتحت ظروف قشطية وجرعات غاما مختلفتين، وقد أشاروا أيضا إلى أن معدل القشط العام V<sub>B</sub> يزداد أسياً مع الجرعات المُعرَّضة لها الكاشف أو الممتصة من قبل الكاشف تحت شروط معدل جرعة ثابت لأشعة غاما، وتحت ظروف جوية معينة محيطة بالكاشف ووجود الأوكسجين أثناء التعرض إلى غاما. وعليه يمكن كتابة المعادلة التي حصلنا عليها بصيغة عامة مشابهة للصيغة التي أوردها [13،14] وهي:

$$V_{B\gamma} = V_{Bo} e^{g D\gamma}$$
(4)

وهكذا فإنَّ الصيغة العامة للمعادلة هذه تمثل معادلة معايرة الكاشف لأشعة غاما تحت أية ظروف تجريبية؛ أي أن بالإمكان استعمال الكاشف كمقياس لجرعة غاما التي تعرَّض لها الكاشف أو الجرعة التي امتصها.

يُمثُل المتغير y في المعادلة (3) معدل القشط العام a يُمثُل المتغير y في المعادلة (3) للكاشف المُعاملان (V<sub>B</sub>) للكاشف المُعرَض إلى وd معدل القشط العام للكاشف (القياسي) غير المُعرَض إلى أشعة غاما (V<sub>B</sub>) والمعلم المُميَّز (V<sub>B</sub>)

parameter) للتعرض لأشعة غاما (g) ويقاس بوحدة Gy ، على التوالى.  $a=V_{
m Bo}$  هو نقطة تقاطع المنحنى مع محور  $^1$ معدل القشط العام ويساوى 1.727 µm/h وهذه القيمة متطابقة تقريبا مع القيمة المقاسة المعطاة في الجدول (1) وهى 1.703 µm/h، وهذه القيمة تعتمد على نوع الكاشف والظروف القشطية من نوع المحلول وعياريته ودرجة حرارته. أما  $D_{\gamma}$  فإنه يمثل جرعة التعرض (أو الامتصاص) لأشعة غاما بوحدة غراي (Gy). ومن المواءمة نجد أنَّ  $.g = 94.5 \text{ MGy}^{-1}$ 

إن نتائجنا بطريقة قياس قطر-طول الأثر (D-Le) للكاشف CR-39 تتفق بشكل جيد مع نتائج المرجع [15] للكاشف CR-39 نفسه باستخدام طريقة قياس مختلفة وهي طريقة القياس التثاقلي gravitational method (أي فرق الكتلة الناتج من عمليات القشط المتعاقبة للكاشف) عند الظروف التجريبية نفسها ولجرعات غاما نفسها المستخدمة فى هذا البحث فضلاً عن استخدامه لجرعات إضافية أخرى مختلفة وكما هو واضح من مقارنة النتائج في الشكل (6). فقد وجد [15] وكما موضح في الشكل (6) أن العلاقة بين معدل القشط العام للكاشف CR-39 وجرعات أشعة غاما تزداد أسيا وتتبع العلاقة العامة نفسها في المعادلة (3  $V_{B0}=1.74 \ \mu m/h$  أو 4) وأن نقطة التقاطع تساوى (4) والقيمة التى قاسها بطريقة القياس التثاقلي  $g=90.3 \text{ MGy}^{-1}$  كانت $V_{B0}=1.73$ ،وإن المَعلم المُميز كان وهذه النتائج متفقة مع النتائج التي حصلنا عليها. كذلك

تتفق نتائجنا مع ما وجده [13] بتعريض كاشف CR-39  $^{60}$ Co الأشعة غاما بمعدل جرعة  $6~{
m kGy/h}$  من مصدر  $6~{
m kGy/h}$ وتحت ظروف تجريبية مختلفة، من أن معدل القشط العام للكاشف يزداد تقريباً على شكل أسى مع جرعة أشعة غاما وإنها تتبع العلاقة العامة نفسها في المعادلة (3 أو 4)، ووجد أن المَعلم المُميِّز (g) كان بحدود  $.g = 35.9 \text{ MGy}^{-1}$ 

وجدير بالذكر فإن قيمة المَعلم المُميِّز (g) يعتمد بشكل قوى على معدل الجرعة الممتصة لأشعة غاما في الكاشف (R(Gy/h، وتتغير مع الجرعة الممتصة (Gy)، فى حالة تغير معدل الجرعة، وكذلك يعتمد على الظروف القشطية والتجريبية، ويعتمد أيضا على الظروف الجوية المحيطة بالكاشف أثناء التعريض لأشعة غاما التى ترتبط بشكل وثيق بوجود الأوكسجين ومقدار ما يتسرب منه خلال سطح الكاشف أثناء التعرض لأشعة غاما وما يذوب (dissolved oxygen) داخله في منطقة التلف الناتج من الجسيم المشحون تحت سطح الكاشف.

ويمكن إيجاد قيم المَعلَم المُميِّز (g) كذلك من رسم  $(D_\gamma)$  العلاقة بين $(N_{B\gamma}\,/\,V_{Bo})$  وجرعة أشعة غاما  $(D_\gamma)$ كما موضح في الشكل (7)، حيث نحصل على خط مستقيم ميله يساوي قيمةg، ويظهر من الشكل أنً  $.g = 94.5 \text{ MGy}^{-1}$ 

4.5

4

Bulk Etch Rate, V<sub>B</sub> (µm /h) 3.5 3 2.5 2 1.5 2 6 0 4 8 10 12 Gamma Dose, Dy (kGy)

= 1.727 e<sup>0.0945x</sup>

15 : y = 1.740 e

الشكل (6): مقارنة معدل القشط العام للكاشف CR-39 المُعرّض لأشعة غاما مع نتائج المرجع [15]



الشكل (7): العلاقة بين لوغاريتم معدل القشط النسبوى للكاشف CR-39 وجرعة غاما المُعرّض لها

الاستنتاجات

كونها تعتمد على القياس المباشر لأقطار الآثار وأطوالها من صور المقاطع الجانبية لصور الآثار. وعليه يمكن القول انه بقياس معدل القشط العام والاعتماد على المعادلة التي تم الحصول عليها ومن حساب قيمة المعلم المُميَّز للتعرض لأشعة كاما (g) فإنه من الممكن معايرة الكاشف واستعماله كمقياس لمعدل جرعات أشعة غاما.

- [8] Ipe, N.E. and Ziemer, D.L., Nucl. Tracks, 11(3) (1986) 137.
- [9] Balestra, S., Cozzi, M., Giacomelli, G., Giacomelli, R., Giorgini, M., Kumar, A., Mandrioli, G., Manzoor, S., Margiotta, A.R., Medinaceli, E., Partizii, L., Popa, V., Qureshi, I.E., Rana, M.A., Sirri, G., Spurio, M., Togo, V. and Valieri, C., Nucl. Instr. and Meth. in Physics Research, B 254 (2007) 254.
- [10] Al-Nia'emi, S.H. and Kasim, Y.Y., Jordan J. Phys., 6(1) (2013) 17.
- [11] Manzoor, S., Balestra, S., Cozzi, M., Errico, M., Giacomelli, G., Giorgini, M., Kumar, A., Margiotta, A., Medinaceli, E., Patrizii, L., Popa, V. Qureshi, I.E. and Togo, V., Nucl. Phys. Proc. Suppl., **172** (2007) 92. DOI:0.1016/j.nuclphysbps.2007.07.017.

من خلال النتائج التي حصلنا عليها يمكن أن نستنتج أن تعريض الكاشف CR-39 إلى جرعات من أشعة غاما يظهر تأثيراً ملحوظاً على خصائص الكاشف ولاسيما معدل القشط العام VB إذ يتغير طردياً وبشكل أسي مع زيادة جرعة أشعة غاما، وإن طريقة D-L المستخدمة في حساب معدل القشط العام VB هي طريقة جيدة وتعطى نتائج جيدة

#### المراجع References

- Szydlowski, A., Sadowski, M., Czyzewski, T., Jaskola, M., Kormona, A., Kedzierski, J. and Krestschmer, W., Radiat. Meas., 312 (1999) 257.
- [2] Nikezic, D. and Yu, K.N., Materials Science and Engineers, R 46 (2004) 51.
- [3] Randhaw, G.S., Shyam, K. and Virk, H.S., Radiat. Meas., 22(3) (1979) 523.
- [4] Khan, H.A., Nucl. Instr. and Meth., 78 (1980) 491.
- [5] Durrani, S.A. and Bull, R.K., "Solid state nuclear track detection", (Pergamon Press, Oxford, 1987).
- [6] Yamauchi, T., Ichijo, H. and Oda, K., Radiat. Meas., 34 (2001) 85.
- [7] Tager, A.A., "Physical chemistry of polymers". (Mir. Publishers, Moscow, USSR, 1978).

- [14] Yamauchi, T., Taniguchi, T., Oda, K., Ikeda, T., Honda, Y. and Tagawa, S., Radiat. Meas., 31 (1999) 121-126.
- [15] Al-Hubayti, Y.Y., M.Sc. Thesis, Physics Dept., College of Education, University of Mosul, Iraq (2005).
- [12] Mahmood, I.H.T, M.Sc. Thesis, Physics Department, College of Education, Mosul University, Iraq (2011).
- [13] Oda, K., Yoshida, K., Yamauchi, T., Ikeda, T., Honda, Y. and Tagawa, S., Radiat. Meas., 28 (1997) 85.